« Réactivité de Surface d'Alumines : des Conditions UHV à l'Interface Solide-Liquide et de l'Oxyde Massif au Film Mince supporté »

Dominique Costa Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces, UMR 7045 ENSCP Chimie-Paristech, 11 rue P. et M. Curie, 75005 Paris

IR Horizon 2014 CP Institut de Recherches Chimie Paris

- Chimie Théorique et Modélisation (CTM) (Carlo Adamo, Alain Fuchs, Dung Di Caprio)
- Interface Electrochimie, Energie (I2E) (B. Diawara, multi-échelle appliqué à la corrosion)
- Physico-Chimie des Surfaces (D. Costa, Réactivité de Surfaces, DFT)

Approche Multi-Echelle de la croissance de films passifs



Simulation à l'échelle mésoscopique de la croissance du film passif



Equipe de Physico-Chimie des Surfaces, Axe de Modélisation

- En résonance avec les grands axes de l'équipe de Physico-Chimie des Surfaces, il s'agit de décrire à l'échelle atomique la réactivité de surfaces métalliques et d'oxydes et de films minces d'oxydes sur métaux et alliages.
- L'accent est ainsi mis sur la réactivité des oxydes vis-à-vis d'entités chimiques corrosives, ou inhibitrices de corrosion, ainsi que sur la compréhension des interactions molécules-surface pour de petites molécules organiques et d'intérêt biologique.
 - Le rôle du solvant (eau) dans les propriétés d'interface est pris en compte.

Oxide/Water Interfaces from Experiments

VSFG : Vibrational Sum Frequency Generation, non-linear spectroscopy

Exps : Shen et al. (USA)

Ice-like layer at the contact with Quartz



High Energy Transmission Reflexion

Exps : Engemann

Liquid-like layer at the contact with amorphous



HARD MATTER HAS THE LAST WORD !

Boehmite (101) surface



Three types of OH groups Music's charge zero pZc of boehmite 8-9 The Calculated Proton Association Constants for Several Important Surface Reactions at Various Important (Hydr)oxides^{*a*}

Surface group	Formal charge	log K	L
Al-OH	$-\frac{1}{2}$	10.0	2.59
Al ₂ –O	$-\overline{1}$	12.3	2.43
Al ₂ –OH	0	-1.5	2.43
Al ₃ –O	$-\frac{1}{2}$	2.2	2.49



Motta , Gaigeot, Costa, J. Phys. Chem C 2012

b)

Conductivité protonique@steps

a)



Grotthus mechanism for H exchange

 μ 1-HOH + μ 2-OH \longrightarrow μ 1-OH + μ 2-HOH Δ pK(μ 1-OH) = 1.4 MUSIC predicts 2-3 units pK difference (Jolivet et al 2004)

Décembre 2013: Workshop « Oxydes/Solution » CFCAM, Paris

Ab Initio Study of the dioxygen reduction on oxidized Al at the solid-liquid interface

T. Ribeiro, D. Costa, F. Mercuri, G. Pacchioni, S. Zanna, M-P. Gaigeot, P. Marcus

- Cathodic reduction of O₂
- The metal is covered with an oxide film
- Water
- Ab initio modeling of complex aspects: cathodic reduction on a metal covered with an oxide film on metal in the presence of solvent







Experimental Evidence (XPS)

- Al₂O₃/Al, Al-rich, reactivity towards O₃ and Cl₂
- Oxide film 20Å, non reactive towards O₂, reactive towards O₃, inner barrier with a high potential drop

10312 Langmuir, Vol. 16, No. 26, 2000



Figure 6. Schematic potential energy diagram of electron tunneling from the Al metal to the broadened and lowered affinity level of the X molecule. The tunneling causes charging of the adsorbed molecules $(X^{\delta-})$.

Model Elaboration

A tuneable Model of Epitaxial Al(111)/ γ -Al₂O₃(111)/AlOOH



Several films are built to account for different thermodynamical conditions (O_2 , H_2O)

Films modélisés (1)



 $\Phi_{\rm e}$ = 6.35 eV

4.16eV

DOS du Film Epais



Charges Bader: Transfert film-> métal

Film Mince

Mince Al-rich



Charges Bader: Transfert métal->film

Films modélisés (2)



Transfert de charge vers O₂



$Er = EA(O_2)- \Phi e + Erelax,$ film mince Al-rich



O_2 Reduction, a two e- process

- $O_2 + 2e + 2H^+ \rightarrow H_2O_2$ and $H_2O_2 + 2e + 2H^+ \rightarrow 2H_2O$
- Spontaneous reactions, no activation barrier
- $\Delta E_{react} = -4.3 (-5.8) eV$
- Hydroxylated oxide acts as a proton reservoir
- Bader charge analysis shows that electrons originate from the interface layer and surface



Acidic character of the hydroxylated oxide.

O₂@MgO/Mo; O₂@MgO/Ag

Frondelius et al, Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, 12, 1483

O₂ reduction at the Al₂O₃-Water interface



Merci pour votre Attention